

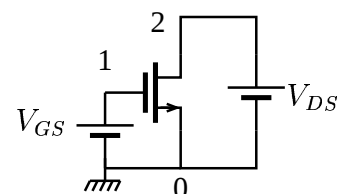
MOSFET a canale n - caratteristiche d'uscita

* caratteristiche d'uscita di un NMOS ad arricchimento

```
VGS 1 0 DC 0
VDS 2 0 DC 0
M1 2 1 0 0 MOSN
.MODEL MOSN NMOS VTO=2 KP=4.0E-5 LAMBDA=0.005
.DC VDS 0 6 .1 VGS 3 6 .5
.PRINT DC I(VDS)
.END
```

- provare con un diverso valore di λ .

• • • • •



MOSFET a canale n - caratteristica mutua

* caratteristica mutua di un NMOS ad arricchimento

```
VGS 1 0 DC 0
VDS 2 0 DC 10
M1 2 1 0 0 MOSN
.MODEL MOSN NMOS VTO=2 KP=4.0E-5 LAMBDA=0.005
.DC VGS 2 6 .1
.PRINT DC I(VDS)
.END
```

- provare con un diverso valore di V_{DS} .
- provare a rappresentare contemporaneamente più curve, corrispondenti a diversi valori di V_{DS} .

• • • • •

MOSFET a canale n - punto di riposo

* punto di riposo

```
VDD 1 0 DC 12
R1 1 2 27k
R2 2 0 28.6k
RD 1 3 2.2k
RS 4 0 1k
M1 3 2 4 4 MOSN
.MODEL MOSN NMOS VTO=2 KP=4.0E-5 LAMBDA=0.005
.OP
.END
```

